

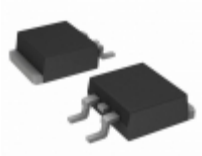


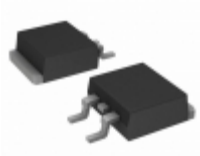




	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB039N10N3GATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 160A TO263-7</p>
	<p>Datenblätter:  IPB039N10N3GATMA1.pdf</p>
<p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPB039N10N3GATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 160A TO263-7
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 160µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-7
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.9 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	214W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-7, D²Pak (6 Leads + Tab), TO-263CB
Andere Namen	IPB039N10N3 GDKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	8410pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	117nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 160A (Tc) 214W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	160A (Tc)

IPB039N10N3GATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB039N10N3GATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB039N10N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB039N10N3GATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB03N03LA G Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 80A TO-263</p>	 <p>IPB039N10N3 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 160A TO263-7</p>	 <p>IPB039N10N3G INFINEO IPB039N10N3G INFINEO</p>	 <p>IPB039N04LGATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 80A TO263-3</p>
 <p>IPB03N03LAG VB IPB03N03LAG VB</p>	 <p>IPB039N04LG VB IPB039N04LG VB</p>	 <p>IPB03N03LA Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 80A D2PAK</p>	 <p>IPB039N10N3GATMA INFINEO INFINEO TO-263</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB039N10N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB039N10N3GATMA1 Datenblatt	IPB039N10N3GATMA1-Datenblätter	IPB039N10N3GATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB039N10N3GATMA1
IPB039N10N3GATMA1 Electronic	IPB039N10N3GATMA1-Komponenten	IPB039N10N3GATMA1-Verteiler	IPB039N10N3GATMA1-Bild	IPB039N10N3GATMA1-Teil
IPB039N10N3GATMA1 Preis	IPB039N10N3GATMA1 Hersteller	IPB039N10N3GATMA1 Bild	IPB039N10N3GATMA1 Aktie	IPB039N10N3GATMA1 Inventar
IPB039N10N3GATMA1 Neu	IPB039N10N3GATMA1 Original	IPB039N10N3GATMA1 garantiert	IPB039N10N3GATMA1 RFQ	IPB039N10N3GATMA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited